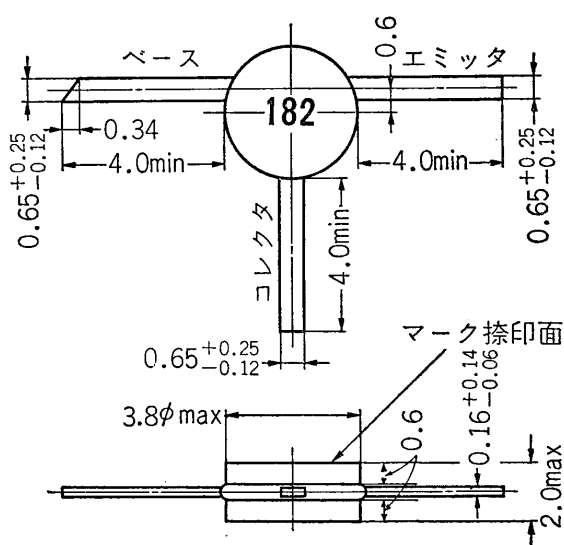


2SC182

NPNエピタキシャルプレーナ形シリコントランジスタ
マイクロディスク
低周波出力増幅用

- ラジオ、テレビなどのドライブ出力段用として最適。
- 外形が小さいので機器の小形化が可能。
- 自動生産ラインの採用により特性が均一。
- エピタキシャル技術の採用によりコレクタ飽和電圧が低い。

外形図 (単位: mm)

絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

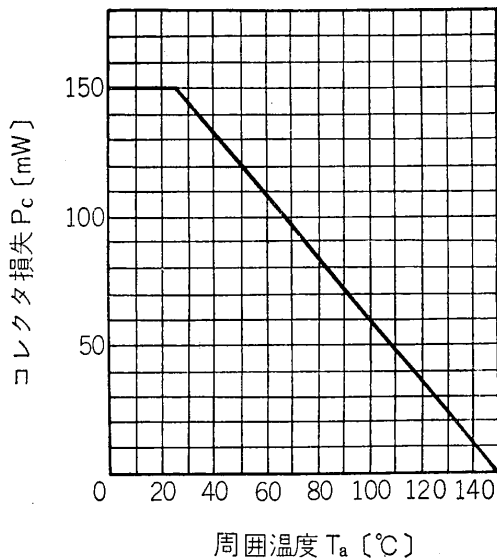
項目	略号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	25	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	15	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	5.0	V
コレクタ電流	I_C	150	mA
コレクタ損失	P_C	150	mW
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-30~+150	$^\circ\text{C}$

電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

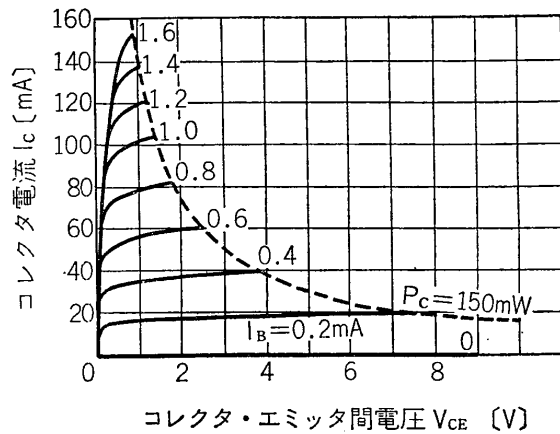
項目	略号	条件	最小	標準	最大	単位
コレクタしゅ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0$			1.0	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=1.0\text{V}, I_C=20\text{mA}$	50	80	300	
直流ベース電圧	V_{BE}	$V_{CE}=6.0\text{V}, I_C=1.0\text{mA}$		0.63		V
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100\text{mA}, I_B=5.0\text{mA}$		0.25	0.60	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=6.0\text{V}, I_E=-1.0\text{mA}$	30	90		MHz
ベース広がり抵抗	$r_{bb'}$	$V_{CE}=6.0\text{V}, I_E=-1.0\text{mA}$ $f=200\text{MHz}$		25		Ω
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB}=6.0\text{V}, I_E=0$ $f=1.0\text{MHz}$		6.5	10	pF

特性曲線 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

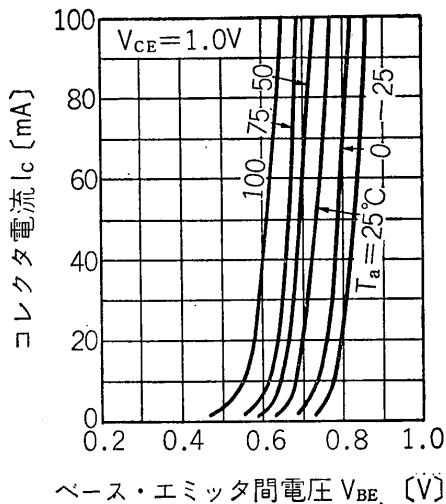
T_a-P_C 特性



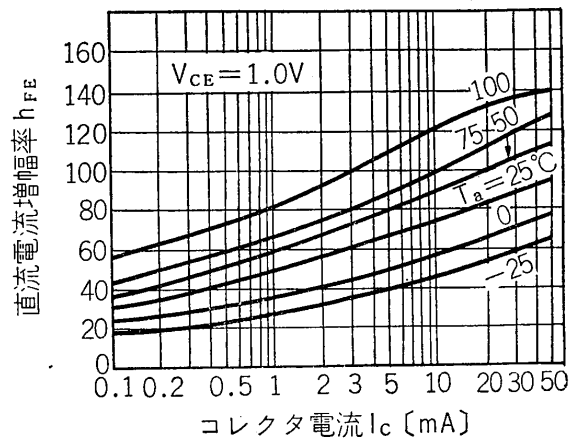
$V_{CE}-I_C$ 特性



$V_{BE}-I_C$ 特性

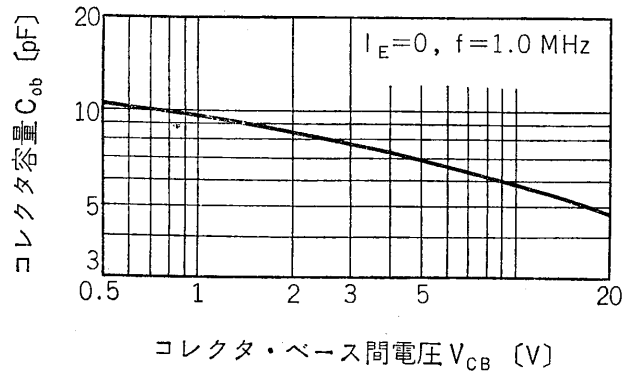


I_C-h_{FE} 特性

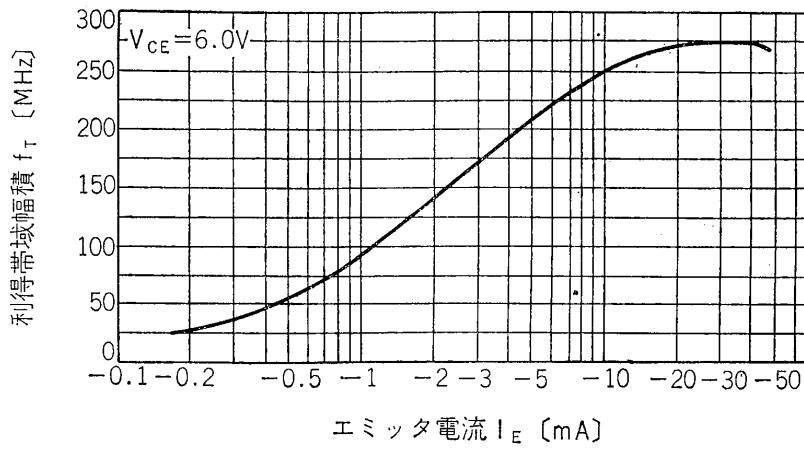


トランジスタ

$V_{CB}-C_{ob}$ 特性



I_E-f_T 特性



注) 2SC182 は、 V_{BE} により次の 2 種類に分けられています。

2SC182 : $V_{BE}=0.60\sim 0.66V$

2SC182 (1) : $V_{BE}=0.58\sim 0.64V$